

**Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»**

Направление подготовки/специальность: 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы

Наименование образовательной программы: Радиоэлектронные системы и комплексы

Уровень образования: высшее образование - специалитет

Форма обучения: Очная

**Оценочные материалы
по дисциплине
Электроника**

**Москва
2025**

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗРАБОТАЛ:

Разработчик

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Торина Е.М.
	Идентификатор	Rf078b9d4-DrozdovaYM-9d5fc66c

Е.М. Горина

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель
образовательной
программы

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Сизякова А.Ю.
	Идентификатор	R4eb30863-SiziakovaAY-83831ea7

А.Ю.
Сизякова

Заведующий
выпускающей кафедрой

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Куликов Р.С.
	Идентификатор	R7ef0b374-KulikovRS-e851162c

Р.С. Куликов

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Оценочные материалы по дисциплине предназначены для оценки достижения обучающимися запланированных результатов обучения по дисциплине, этапа формирования запланированных компетенций и уровня освоения дисциплины.

Оценочные материалы по дисциплине включают оценочные средства для проведения мероприятий текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Формируемые у обучающегося компетенции:

1. ОПК-2 Способен выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-математический аппарат для их формализации, анализа и принятия решения

ИД-2 Осуществляет сбор и анализ научно-технической информации, составляет аналитические обзоры и научно-технические отчеты по результатам выполненной работы

2. ОПК-4 Способен проводить экспериментальные исследования и владеть основными приемами обработки и представления экспериментальных данных

ИД-1 Знает основные методы и средства проведения экспериментальных исследований

ИД-2 Выбирает способы и средства измерений и проводит экспериментальные исследования

и включает:

для текущего контроля успеваемости:

Форма реализации: Допуск к лабораторной работе

1. ЛР №1.1. Статические характеристики п/п диодов (Лабораторная работа)

2. ЛР №1.2. Статические характеристики биполярных транзисторов (Лабораторная работа)

Форма реализации: Письменная работа

1. КР №1.1. Физические основы электропроводности п/п. (Контрольная работа)

Форма реализации: Смешанная форма

1. ЛР №1.3 + КР №1.2. Зачет по разделу БТ (Отчет)

2. ЛР №1.4 + КР №1.3. Зачет по разделу ПТ (Отчет)

БРС дисциплины

4 семестр

Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости по дисциплине:

КМ-1 ЛР №1.1. Статические характеристики п/п диодов (Лабораторная работа)

КМ-2 КР №1.1. Физические основы электропроводности п/п. (Контрольная работа)

КМ-3 ЛР №1.2. Статические характеристики биполярных транзисторов (Лабораторная работа)

КМ-4 ЛР №1.3 + КР №1.2. Зачет по разделу БТ (Отчет)

КМ-5 ЛР №1.4 + КР №1.3. Зачет по разделу ПТ (Отчет)

Вид промежуточной аттестации – Экзамен.

Раздел дисциплины	Веса контрольных мероприятий, %					
	Индекс КМ:	КМ-1	КМ-2	КМ-3	КМ-4	КМ-5
	Срок КМ:	4	8	12	14	16
Физические основы полупроводниковой электроники						
Физические основы полупроводниковой электроники			+			
Физические основы работы оптоэлектронных элементов						
Оптоэлектронные полупроводниковые элементы и структуры			+			
Контактные явления. Электронно-дырочный переход, барьер Шоттки, гетеропереходы						
Контактные явления. Электронно-дырочный переход, барьер Шоттки, гетеропереходы	+	+				
Полупроводниковые диоды на основе электронно-дырочного перехода.						
Полупроводниковые диоды на основе электронно-дырочного перехода.	+	+				
Биполярные транзисторы						
Биполярные транзисторы				+	+	
Полевые транзисторы						
Полевые транзисторы						+
Вес КМ:	8	12	20	30	30	

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

I. Оценочные средства для оценки запланированных результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Индекс компетенции	Индикатор	Запланированные результаты обучения по дисциплине	Контрольная точка
ОПК-2	ИД-2 _{ОПК-2} Осуществляет сбор и анализ научно-технической информации, составляет аналитические обзоры и научно-технические отчеты по результатам выполненной работы	Знать: основные типы полупроводниковых диодов, их модели и способы количественного описания с привлечением соответствующего физико-математического аппарата основные типы полевых транзисторов, их модели и способы количественного описания с привлечением соответствующего физико-математического аппарата основные типы биполярных транзисторов, их модели и способы количественного описания с привлечением соответствующего физико-математического аппарата физическое основы электропроводности	КМ-1 ЛР №1.1. Статические характеристики п/п диодов (Лабораторная работа) КМ-2 КР №1.1. Физическое основы электропроводности п/п. (Контрольная работа) КМ-8 ЛР №1.3 + КР №1.2. Зачет по разделу БТ (Отчет) КМ-9 ЛР №1.4 + КР №1.3. Зачет по разделу ПТ (Отчет)
ОПК-4	ИД-1 _{ОПК-4} Знает основные методы и средства	Знать: методы математического	КМ-1 ЛР №1.1. Статические характеристики п/п диодов (Лабораторная работа)

	<p>проведения экспериментальных исследований</p>	<p>моделирования основных характеристик биполярных транзисторов и описания принципов их работы с использованием типовых моделей и стандартных прикладных программ методы математического моделирования основных характеристик полупроводниковых диодов и описания принципов их работы с использованием типовых моделей и стандартных прикладных программ методы математического моделирования основных характеристик полевых транзисторов и описания принципов их работы с использованием типовых моделей и стандартных прикладных программ Уметь: проводить расчет вольт-амперных характеристик биполярных транзисторов с помощью соответствующего физико-математического аппарата проводить расчет вольт-амперных характеристик</p>	<p>КМ-3 ЛР №1.2. Статические характеристики биполярных транзисторов (Лабораторная работа) КМ-8 ЛР №1.3 + КР №1.2. Зачет по разделу БТ (Отчет) КМ-9 ЛР №1.4 + КР №1.3. Зачет по разделу ПТ (Отчет)</p>
--	--	--	---

		<p>полевых транзисторов с помощью соответствующего физико-математического аппарата проводить расчет вольт-амперных характеристик полупроводниковых диодов с помощью соответствующего физико-математического аппарата</p>	
ОПК-4	ИД-2опк-4 Выбирает способы и средства измерений и проводит экспериментальные исследования	<p>Знать: типовые режимы использования полевых транзисторов типовые режимы использования полупроводниковых диодов типовые режимы использования биполярных транзисторов Уметь: экспериментально определять основные характеристики и параметры моделей полевых транзисторов экспериментально определять основные характеристики и параметры моделей полупроводниковых диодов</p>	<p>КМ-1 ЛР №1.1. Статические характеристики п/п диодов (Лабораторная работа) КМ-8 ЛР №1.3 + КР №1.2. Зачет по разделу БТ (Отчет) КМ-9 ЛР №1.4 + КР №1.3. Зачет по разделу ПТ (Отчет)</p>

		экспериментально определять основные характеристики и параметры моделей биполярных транзисторов	
--	--	---	--

II. Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания

КМ-1. ЛР №1.1. Статические характеристики п/п диодов

Формы реализации: Допуск к лабораторной работе

Тип контрольного мероприятия: Лабораторная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 8

Процедура проведения контрольного мероприятия: Проверка подготовки к лабораторной работе, опрос по контрольным вопросам.

Краткое содержание задания:

Измерение статических характеристик полупроводниковых диодов

Контрольные вопросы/задания:

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
Знать: основные типы полупроводниковых диодов, их модели и способы количественного описания с привлечением соответствующего физико-математического аппарата	1. Перечислите основные типы диодов
Знать: методы математического моделирования основных характеристик полупроводниковых диодов и описания принципов их работы с использованием типовых моделей и стандартных прикладных программ	1. Пояснить, каким образом получается изображение статической характеристики диода на экране осциллографа. Какую роль играет форма импульсов напряжения? 2. Как называются диоды, используемые как переменные конденсаторы в радиоэлектронных устройствах?
Знать: типовые режимы использования полупроводниковых диодов	1. Как влияет увеличение измерительного сопротивления на форму наблюдаемой характеристики? 2. Как изменится <i>прямая ветвь</i> статической характеристики, если температуру кремниевого диода увеличить на 50 К? 3. В чем сходство и различие <i>прямых ветвей</i> статических характеристик германиевого и кремниевого диодов?
Уметь: проводить расчет вольт-амперных характеристик полупроводниковых диодов с помощью соответствующего физико-математического аппарата	1. Составить схему для измерения статических характеристик диодов
Уметь: экспериментально определять основные характеристики и параметры моделей полупроводниковых диодов	1. Учет и исключение при обработке измерений влияния измерительного сопротивления на форму прямой ветви статической характеристики диода

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5 («отлично»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4 («хорошо»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

КМ-2. КР №1.1. Физическое основы электропроводности п/п.

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 12

Процедура проведения контрольного мероприятия: Каждый студент получает индивидуальное задание из 3-х вопросов. В течение 1 ч. 30 мин. студент в аудитории письменно отвечает на эти вопросы.

Краткое содержание задания:

Задано:

Тип материала, тип проводимости п/п, концентрация примеси, концентрация собственных носителей заряда. Температура T_0 , изменение температуры ΔT

Задача 1.

Определить тип примеси. Рассчитать концентрации основных и неосновных подвижных носителей заряда. Как они изменятся при повышении температуры на ΔT ? Если изменятся, то рассчитайте во сколько раз.

Задача 2.

Изобразите и поясните зависимость концентрации основных носителей заряда в зоне проводимости (или в валентной зоне) п/п заданного типа с заданной концентрацией примеси от температуры в интервале $0 < T < 600$ К. Как она изменится, если концентрация примеси станет в 4 раза выше и почему?

Задача 3

Рассчитайте удельные проводимости чистого п/п и п/п с заданной примесью при $T=T_0$ и заданной концентрация собственных носителей заряда, если подвижность электронов $\mu_n = 3900$ см²/В с, подвижность дырок $\mu_p = 1900$ см²/В с. Как изменятся эти проводимости с повышением температуры на ΔT К? Если изменятся, то рассчитайте во сколько раз.

Группа/номер в журнале	Тип материала	Концентрация собственных носителей заряда, см ⁻³	Тип проводимости п/п	Концентрация примеси, см ⁻³	T_0	ΔT
------------------------	---------------	---	----------------------	--	-------	------------

11/1	Si	1,5*1010	n-	1015	290	30
11 /2	Ge	2,5*1013	p-	2*1015	300	30
11 /3	Si	1,5*1010	n-	3*1015	310	30
11/4	Ge	2,5*1013	p-	4*1015	290	30
11 /5	Si	1,5*1010	n-	5*1015	300	30
11 /6	Ge	2,5*1013	p-	6*1015	310	30
11 /7	Si	1,5*1010	n-	7*1015	290	30
11 /8	Ge	2,5*1013	p-	8*1015	300	30
11 /9	Si	1,5*1010	n-	9*1015	310	30

Контрольные вопросы/задания:

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
Знать: основные типы полупроводниковых диодов, их модели и способы количественного описания с привлечением соответствующего физико-математического аппарата	<ol style="list-style-type: none"> 1. Какие области возникают при контакте полупроводников p-типа и n-типа 2. Поясните процессы, происходящие в p-n переходе при подаче на него прямого смещения. Покажите, как в обедненном слое искажены энергетические зоны полупроводника при нулевом и положительном смещении. Изобразите распределение концентраций носителей, объемного заряда, внутреннего поля и контактной разности потенциалов в резком ступенчатом p-n переходе при нулевом и положительном смещении.
Знать: физическое основы электропроводности	<ol style="list-style-type: none"> 1. В 4-х валентный элемент введена 5-ти валентная примесь. Определите тип полупроводника 2. В 4-х валентный элемент введена 3-х валентная примесь. Определите тип полупроводника 3. Поясните процессы происходящие в p-n переходе при подаче на него обратного смещения. Поясните процесс формирования пробоя перехода. Типы и особенности пробоев. Изобразите полную статическую ВАХ полупроводникового диода с учетом пробоя.

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5 («отлично»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 90

Описание характеристики выполнения знания: Задание выполнено полностью

Оценка: 4 («хорошо»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Из 3-х заданий выполнено 2.

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 30

Описание характеристики выполнения знания: Из 3-х заданий с незначительными ошибками выполнены все

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Не выполнено ни одно задание или все задания выполнены с грубыми ошибками

КМ-3. ЛР №1.2. Статические характеристики биполярных транзисторов

Формы реализации: Допуск к лабораторной работе

Тип контрольного мероприятия: Лабораторная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 20

Процедура проведения контрольного мероприятия: Проверка подготовки к лабораторной работе, опрос по контрольным вопросам.

Краткое содержание задания:

Измерение статических характеристик биполярных параметров

Контрольные вопросы/задания:

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
Знать: методы математического моделирования основных характеристик биполярных транзисторов и описания принципов их работы с использованием типовых моделей и стандартных прикладных программ	1.Изобразить семейства статических характеристик транзистора. 2.Пояснить, как влияют на ВАХ биполярного транзистора напряжения питания, температура.
Уметь: проводить расчет вольт-амперных характеристик биполярных транзисторов с помощью соответствующего физико-математического аппарата	1.Определение количественных параметров статических характеристик биполярных транзисторов 2.Количественное определение ошибки, которую вносит измерительное сопротивление $R_{и} = 10 \text{ Ом}$ в расчет крутизны проходной характеристики. 3.Пояснить работу характеристики графа.

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5 («отлично»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 90

Описание характеристики выполнения знания: Правильные ответы на все контрольные вопросы, наличие правильной подготовки. Задание выполнено полностью. Есть опечатки в оформлении отчета

Оценка: 4 («хорошо»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 75

Описание характеристики выполнения знания: Не все ответы на все контрольные вопросы верные, наличие правильной подготовки. Задание выполнено полностью. Есть ошибки в расчетах

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Неточные ответы на все контрольные вопросы, наличие правильной подготовки. Задание выполнено полностью. Есть грубые ошибки в измерениях и оформлении отчета

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "не зачтено" выставляется если задание не выполнено в отведенный срок или результат не соответствует заданию

КМ-4. ЛР №1.3 + КР №1.2. Зачет по разделу БТ

Формы реализации: Смешанная форма

Тип контрольного мероприятия: Отчет

Вес контрольного мероприятия в БРС: 30

Процедура проведения контрольного мероприятия: ЛР №1.3: Проверка подготовки к лабораторной работе, опрос по контрольным вопросам. КР №1.2: каждый студент получает индивидуальное задание из 4-х вопросов. В течение 1 ч. 30 мин. студент в аудитории письменно отвечает на эти вопросы.

Краткое содержание задания:

Измерение и расчет параметров малосигнальной эквивалентной схемы биполярного транзистора импульсным методом. Определение областей работы биполярного транзистора и соответствие эквивалентной нелинейной и линейной схемы этой области

Контрольные вопросы/задания:

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
Знать: основные типы биполярных транзисторов, их модели и способы количественного описания с привлечением соответствующего физико-математического аппарата	1.Изобразите малосигнальную ВЧ эквивалентную схему БТ для активной области (схему Джаколетто). Поясните физический смысл ее элементов. Для режима, в котором постоянный ток коллектора $I_{К0} = 10 \text{ мА}$, $CЭ = 8 \text{ пФ}$, $СКП = СКА = 1 \text{ пФ}$, $rб = 100 \text{ Ом}$, $\beta = 100$, $fT = 300 \text{ МГц}$, рассчитайте диффузионную емкость, крутизну по входу S на низкой частоте и граничную частоту по коэффициенту передачи по току β . Поясните смысл этой частоты. 2.Изобразите схему передаточной зарядовой модели для активной области работы биполярного транзистора.
Знать: методы математического моделирования основных характеристик биполярных транзисторов и описания принципов их работы с использованием типовых моделей и стандартных прикладных программ	1.Поясните физический смысл элементов малосигнальной эквивалентной схемы транзистора. 2.Что такое граничная частота по крутизне.
Знать: типовые режимы использования биполярных транзисторов	1.Напишите уравнения для расчета входных, проходных и выходных характеристик БТ, включенного по схеме ОЭ. Изобразите входные и проходные характеристики для активной области и области насыщения характеристики.
Уметь: проводить расчет вольт-амперных характеристик биполярных транзисторов с помощью соответствующего физико-математического аппарата	1.Определение областей работы биполярных транзисторов и соответствующих эквивалентных схем
Уметь: экспериментально определять основные характеристики и параметры моделей биполярных	1.Определение элементов эквивалентной схемы БТ, пользуясь осциллограммами переходных процессов.

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
транзисторов	

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5 («отлично»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4 («хорошо»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

КМ-5. ЛР №1.4 + КР №1.3. Зачет по разделу ПТ

Формы реализации: Смешанная форма

Тип контрольного мероприятия: Отчет

Вес контрольного мероприятия в БРС: 30

Процедура проведения контрольного мероприятия: ЛР №1.4: проверка подготовки к лабораторной работе, опрос по контрольным вопросам. КР №1.3: каждый студент получает индивидуальное задание из 4-х вопросов. В течение 1 ч. 30 мин. студент в аудитории письменно отвечает на эти вопросы.

Краткое содержание задания:

Измерение статических характеристик полевых транзисторов. Изобразить условное графическое обозначение МОП с индуцированным n-каналом. Изобразить проходную и выходную характеристики заданного ПТ. Изобразить структуры заданного ПТ при работе в крутой и пологой области. Рассчитать крутизну проходной характеристики ПТ, если известны параметры параболической аппроксимации проходной характеристики и рабочая точка. Изобразить эквивалентную схему ПТ, работающего в пологой области на умеренно высоких частотах.

Контрольные вопросы/задания:

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
Знать: основные типы полевых транзисторов, их модели и способы количественного описания с привлечением соответствующего физико-математического аппарата	1.Эквивалентные малосигнальные схемы полевых транзисторов на средних и умеренно-высоких частотах.
Знать: методы математического моделирования основных характеристик полевых транзисторов и описания принципов их работы с использованием типовых моделей и	1.Области работы полевых транзисторов 2.Условные графические обозначения полевых транзисторов разного типа.

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
стандартных прикладных программ	3.Области работы полевых транзисторов.
Знать: типовые режимы использования полевых транзисторов	1.Методика расчета крутизны проходной характеристики и выходного дифференциального сопротивления полевого транзистора 2.Принцип работы характериографа
Уметь: проводить расчет вольт-амперных характеристик полевых транзисторов с помощью соответствующего физико-математического аппарата	1.Уметь рассчитывать параметры модели полевого транзистора в заданной рабочей точке 2.Уметь рассчитывать по модели вольт-амперные характеристики разных типов полевых транзисторов 3.Расчет малосигнальных параметров полевых транзисторов по статическим характеристикам в рабочей точке.
Уметь: экспериментально определять основные характеристики и параметры моделей полевых транзисторов	1.Проводить измерение статических характеристик полевых транзисторов по стрелочным приборам и с помощью характериографа

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5 («отлично»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4 («хорошо»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

4 семестр

Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Пример билета

1. Концентрация собственных носителей тока в Ge $n_i = 2.25 \cdot 10^{10} \text{ м}^{-3}$ подвижность электронов $\mu_n = 0,4 \text{ м}^2/\text{Вс}$, подвижность дырок $\mu_p = 0,2 \text{ м}^2/\text{Вс}$. Определите проводимости а) чистого германия, б) германия, легированного элементом 3 группы, если концентрация легирующих примесей равна $4,5 \cdot 10^{11} \text{ м}^{-3}$ и все примеси ионизированы, в) германия, легированного элементом 5 группы, если концентрация легирующих примесей равна $4,5 \cdot 10^{12} \text{ м}^{-3}$ и все примеси ионизированы.
2. Изобразите малосигнальную высокочастотную эквивалентную схему биполярного транзистора для активной области (схему Джиаколетто). Поясните физический смысл ее элементов. Для режима, в котором постоянный ток коллектора $I_{к0} = 5 \text{ мА}$, $C_{э} = 8 \text{ пФ}$, $C_{ка} = C_{кп} = 1 \text{ пФ}$, $r_{б} = 100 \text{ Ом}$, $\beta = 100$, $f_T = 800 \text{ МГц}$ найдите диффузионную емкость СД, крутизну проходной характеристики транзистора на низкой частоте и граничную частоту по крутизне.

Процедура проведения

Проводится в устной форме по билетам в виде подготовки и изложения развернутого ответа. Время на подготовку ответа – 60 минут.

1. Перечень компетенций/индикаторов и контрольных вопросов проверки результатов освоения дисциплины

1. Компетенция/Индикатор: ИД-2_{ОПК-2} Осуществляет сбор и анализ научно-технической информации, составляет аналитические обзоры и научно-технические отчеты по результатам выполненной работы

Вопросы, задания

1. Что такое эффективная плотность состояний электронов в зоне проводимости? Как она зависит от температуры и почему?
2. Изобразите и сравните между собой вольт-фарадные характеристики варикапов с плавным, резким и сверхрезким p - n переходами. Для варикапа с резким ступенчатым переходом изобразить распределения плотности пространственного заряда, напряженности электрического поля и потенциала вдоль оси, перпендикулярной плоскости перехода, при двух значениях закрывающего напряжения.
3. Как зависит от напряжения между затвором и истоком полевого транзистора с управляющим p-n переходом проводимость канала при малых напряжениях между стоком и истоком. При каких условиях полевой транзистор можно использовать как линейное электрически регулируемое сопротивление?
4. Сравните между собой крутизны проходных характеристик биполярного и полевого транзисторов, при параболической аппроксимации, работающих при одинаковых постоянных токах $I_0 = 10 \text{ мА}$, если в полевом транзисторе этот ток соответствует нулевому напряжению затвор-исток при напряжении отсечки - 4 В, а биполярный транзистор имеет сопротивление базы 100 Ом и $\beta = 100$.

5. Изобразите и сравните между собой проходные и выходные характеристики полевых транзисторов с управляющим переходом и n каналом и с наведенным n каналом. Сравните также малосигнальные высокочастотные эквивалентные схемы этих транзисторов.
6. Поясните физический механизм влияния коллекторного напряжения в биполярном транзисторе на ток коллектора. Сравните по степени этого влияния схемы с заданным напряжением база-эмиттер и с заданным током базы. Какие элементы в малосигнальной низкочастотной эквивалентной схеме транзистора отражают это влияние?
7. Поясните принцип действия светодиода
8. Поясните принцип действия фотодиода

Материалы для проверки остаточных знаний

1. В 4-х валентный элемент введена 5-ти валентная примесь. Определите тип полупроводника

Ответы:

Собственный полупроводник Полупроводник p-типа Полупроводник n-типа

Верный ответ: Полупроводник n-типа

2. В 4-х валентный элемент введена 3-х валентная примесь. Определите тип полупроводника

Ответы:

Собственный полупроводник Полупроводник p-типа Полупроводник n-типа

Верный ответ: Полупроводник p-типа

3. Каково напряжение открывания кремниевого полупроводникового диода

Ответы:

0 В 0,2 В 0,6 В

Верный ответ: 0,6 В

4. Определите в какой области работает кремниевый биполярный транзистор, если выполняется следующее условие $U_{бэ}=0,7$ В $U_{кэ}=-3$ В

Ответы:

Активная область Область отсечки Область насыщения Инверсная область

Верный ответ: Активная область

5. Выберите правильное обозначение n-p-n биполярного транзистора, введя номер рисунка 1 или 2

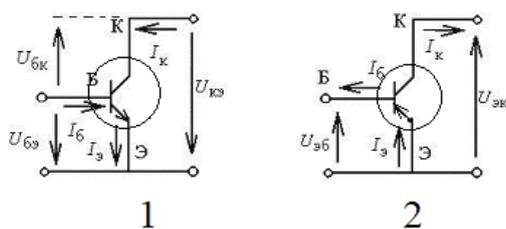


Figure 1 Обозначения биполярного транзистора

Ответы:

1 2

Верный ответ: 1

6. Какой зависимостью описывается проходная характеристика биполярного транзистора

Ответы:

линейная параболическая экспоненциальная

Верный ответ: экспоненциальная

7. Какой зависимостью описывается проходная характеристика полевого транзистора

Ответы:

линейная параболическая экспоненциальная

Верный ответ: параболическая

8. Какой тип рекомбинации лежит в основе принципа действия светодиода

Ответы:

излучательная безизлучательная с образованием фононов

Верный ответ: с образованием фононов

2. Компетенция/Индикатор: ИД-1_{ОПК-4} Знает основные методы и средства проведения экспериментальных исследований

Вопросы, задания

1. Определите в какой области работает n-p-n БТ, если $U_{Б'Э} = 0,65$ В, $U_{КЭ} = 10$ В.

Нарисуйте инжекционную модель БТ, описывающую работу БТ по постоянному току в этой области. Напишите уравнения для расчета входных, проходных и выходных характеристик БТ, включенного по схеме ОБ.

2. Изобразите и поясните проходные и выходные статические характеристики МОП транзистора со встроенным n каналом. Как изменятся эти характеристики при изменении температуры.

3. Определите в какой области находится n-p-n БТ, если $U_{Б'Э} = 0,7$ В, $U_{Б'К} = 1$ В.

Нарисуйте передаточную модель Эберса-Молла БТ, описывающую работу БТ по постоянному току в этой области. Напишите уравнения для расчета входных, проходных и выходных характеристик БТ, включенного по схеме ОЭ. Изобразите все эти характеристики.

Материалы для проверки остаточных знаний

1. Для какой схемы включения биполярного транзистора применяется инжекционная модель транзистора, показанная на рисунке

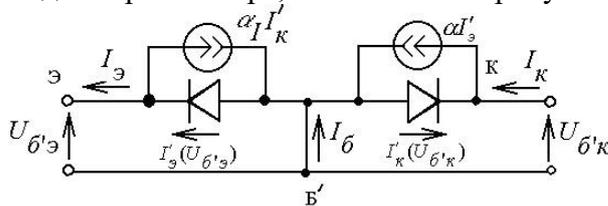


Figure 2 Инжекционная модель биполярного транзистора

Ответы:

Схема с общей базой Схема с общим эмиттером Схема с общим коллектором

Верный ответ: Схема с общей базой

2. Для какой схемы включения биполярного транзистора применяется передаточная модель транзистора, показанная на рисунке

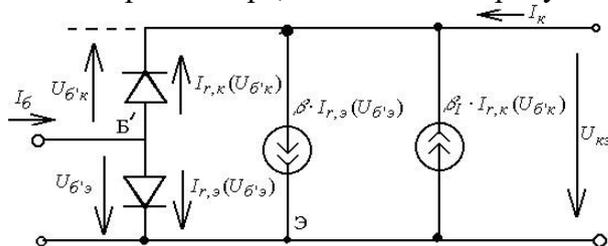


Figure 3 Передаточная модель биполярного транзистора

Ответы:

Схема с общей базой Схема с общим эмиттером Схема с общим коллектором

Верный ответ: Схема с общим эмиттером

3. Для какой области работы справедлива линейная малосигнальная эквивалентная схема Джаколетто, показанная на рис.

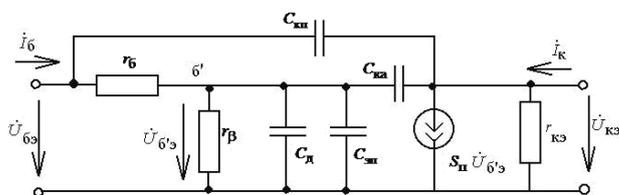


Figure 4 Малосигнальная эквивалентная схема биполярного транзистора

Ответы:

Активная область Область насыщения Инверсная область

Верный ответ: Активная область

3. Компетенция/Индикатор: ИД-2ОПК-4 Выбирает способы и средства измерений и проводит экспериментальные исследования

Вопросы, задания

1. Изобразите и сравните эквивалентные схемы полупроводниковых р - n диодов, используемые для расчетов статических режимов диодов и динамических процессов в них. Постройте статическую характеристику диода, имеющего при $T = 300 \text{ K}$ ток насыщения 10-13 А и сопротивление материала базы 12 Ом при изменении прямого тока до 30 мА.

2. Изобразите малосигнальную высокочастотную эквивалентную схему биполярного транзистора для активной области (схему Джиаколетто). Поясните физический смысл ее элементов. Для режима, в котором постоянный ток коллектора $I_{к0} = 5 \text{ мА}$, $C_{э} = 8 \text{ пФ}$, $C_{ка} = C_{кп} = 1 \text{ пФ}$, $r_{б} = 100 \text{ Ом}$, $\beta = 100$, $f_T = 800 \text{ МГц}$ найдите диффузионную емкость СД, крутизну проходной характеристики транзистора на низкой частоте и граничную частоту по крутизне.

Материалы для проверки остаточных знаний

1. Выберите правильное определение входной характеристики биполярного транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером

Ответы:

Зависимость $I_{б}(U_{бэ})$ при постоянном напряжении $U_{кэ}$ Зависимость $I_{к}(U_{бэ})$ при постоянном напряжении $U_{кэ}$ Зависимость $I_{к}(U_{кэ})$ при постоянном напряжении $U_{бэ}$

Верный ответ: Зависимость $I_{б}(U_{бэ})$ при постоянном напряжении $U_{кэ}$

2. Выберите правильное определение проходной характеристики биполярного транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером

Ответы:

Зависимость $I_{б}(U_{бэ})$ при постоянном напряжении $U_{кэ}$ Зависимость $I_{к}(U_{бэ})$ при постоянном напряжении $U_{кэ}$ Зависимость $I_{к}(U_{кэ})$ при постоянном напряжении $U_{бэ}$

Верный ответ: Зависимость $I_{к}(U_{бэ})$ при постоянном напряжении $U_{кэ}$

3. Выберите правильное определение выходной характеристики биполярного транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером

Ответы:

Зависимость $I_{б}(U_{бэ})$ при постоянном напряжении $U_{кэ}$ Зависимость $I_{к}(U_{бэ})$ при постоянном напряжении $U_{кэ}$ Зависимость $I_{к}(U_{кэ})$ при постоянном напряжении $U_{бэ}$

Верный ответ: Зависимость $I_{к}(U_{кэ})$ при постоянном напряжении $U_{бэ}$

II. Описание шкалы оценивания

Оценка: 5 («отлично»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 90

Описание характеристики выполнения знания: Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется студенту, правильно выполнившему практическое задание, который показал при ответе на вопросы

экзаменационного билета и на дополнительные вопросы, что владеет материалом изученной дисциплины, свободно применяет свои знания для объяснения различных явлений и решения задач.

Оценка: 4 («хорошо»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка «ХОРОШО» выставляется студенту, правильно выполнившему практическое задание и в основном правильно ответившему на вопросы экзаменационного билета и на дополнительные вопросы, но допустившему при этом не принципиальные ошибки.

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, который в ответах на вопросы экзаменационного билета допустил существенные и даже грубые ошибки, но затем исправил их сам, а также не выполнил практическое задание из экзаменационного билета, но либо наметил правильный путь его выполнения, либо по указанию экзаменатора решил другую задачу из того же раздела дисциплины.

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, который: а) не ответил на вопросы экзаменационного билета и не смог решить, либо наметить правильный путь решения задачи из билета; б) не смог решить, либо наметить правильный путь решения задачи из экзаменационного билета и другой задачи на тот же раздел дисциплины, выданной взамен нее; в) при ответе на дополнительные вопросы обнаружил незнание большого раздела экзаменационной программы.

III. Правила выставления итоговой оценки по курсу

Оценка определяется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе для студентов НИУ «МЭИ» на основании семестровой и аттестационной составляющих.